

I dipendenti di KIOXIA ricevono il premio per la scienza e la tecnologia dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia del Giappone

Tokyo, Giappone, 19 aprile 2023 - KIOXIA Corporation, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi che i suoi dipendenti hanno ricevuto il Premio per la Scienza e la Tecnologia dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia per l'invenzione del dispositivo di memoria flash tridimensionale ad alta densità e per il metodo di fabbricazione, che aumenta notevolmente la capacità di memoria e riduce i costi di produzione.

Il premio annuale viene assegnato dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia a persone che hanno realizzato risultati eccezionali nella ricerca e nello sviluppo e hanno promosso la divulgazione della scienza e della tecnologia in Giappone.

Premiazione KIOXIA

- Ryota Katsumata, assistente del General Manager, Advanced Memory Development Center, Memory Division
- Masaru Kito, Group Manager, Advanced Memory Development Center, Memory Division
- Hideaki Aochi, Senior Expert, Device Technology Research & Development Center, Institute of Memory Technology Research and Development
- Masaru Kido, Chief Specialist, Memory Development Strategy Division
- Hiroyasu Tanaka, Chief Specialist, Memory Development Strategy Division

Panoramica della tecnologia premiata

La memoria flash viene utilizzata in una vasta gamma di applicazioni per l'archiviazione dei dati, tra cui smartphone e data center, e la domanda è destinata a crescere.

La tecnologia di memoria tridimensionale flash premiata rappresenta un approccio innovativo che ha semplificato notevolmente il processo di fabbricazione per impilare le celle di memoria verticalmente al fine di realizzare memoria tridimensionale flash ad alta densità. Mentre l'impilamento convenzionale richiedeva ripetuti processi di deposizione e di mascheratura per la fabbricazione di matrici di celle di memoria, questa tecnologia prima impila i materiali per le celle di memoria e poi produce tutte le celle contemporaneamente utilizzando un unico processo di mascheratura, riducendo così significativamente i passaggi di lavorazione. Mentre la tecnologia di miniaturizzazione utilizzata nella memoria flash bidimensionale convenzionale si avvicina ai suoi limiti fisici, la tecnologia di memoria flash tridimensionale ad alta capacità e ad alte prestazioni è ora sempre più applicata nei prodotti leader del mercato. Dopo aver commercializzato la memoria flash tridimensionale BiCS FLASH™ nel 2015, KIOXIA ha lavorato per aumentare la densità di impilamento. Il mese

scorso, KIOXIA ha annunciato la sua memoria flash tridimensionale BiCS FLASH™ ad alte prestazioni e ad alta capacità a 218 strati.

Questa tecnologia di memoria flash tridimensionale è stata anche premiata con l'Imperial Invention Prize dal National Commendation for Invention 2020 e ha ricevuto il premio IEEE Andrew S. Grove Award per il 2021.

Guidata dalla sua missione di "elevare il mondo con la "memoria"", KIOXIA è impegnata nella ricerca e nello sviluppo tecnologico che apporta valore alle persone di tutto il mondo.

Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi i prezzi e le specifiche dei prodotti, il contenuto dei servizi e le informazioni di contatto, sono corrette alla data dell'annuncio, ma soggette a modifiche senza preavviso.